

# 高精度宽量程单相电能计量芯片 90E21/22/23/24 数据手册

版本: 1 2010年9月3日

6024 Silver Creek Valley Road, San Jose, CA 95138 © 2010 Integrated Device Technology, Inc.

免责声明 艾迪悌有限公司(IDT)保留无需事先通知,可随时更改其产品或规格的权利,以改进设计或性能,提供最好的产品。IDT 公司对使用所述任何非 IDT 公司的电路不承担任何责任。IDT 公司对使用所述电路不会侵犯第三方专利权或其它权利不作任何陈述。IDT 公司不对任何受专利或其它权利保护的许可作任示。	司产品所包含 任何明示或暗
生命支持政策 除非与 IDT 公司签订明确的书面协议,否则不得将 IDT 公司产品用作生命支持设备或系统的关键部件。 1. 生命支持设备或系统是指此种设备或系统(a)拟外科植入人体,或者(b)用于生命支持或维持,其正常使用时发生的故障可能会给用户带来严重伤害 2. 关键部件是指生命支持设备或系统中任何发生故障时,可能导致生命支持设备或系统故障,或影响其安全性或有效性的部件。	害。





٠.	<b></b> .:	at, ta	_
严	品律	特性	6
1	H	···	G
产	品	说明	6
тЊ	台上十	模块图	7
1	引	脚分布	. 9
0	11		
3	功	能描述	12
	2 1	1 计量动态范围	
		2 起动与潜动功率	
		3 电能寄存器	
	3. 4	4 N线计量与防窃电功能	13
		3.4.1 计量模式与 L、N 线电流采样增益配置	19
		3.4.2 防窃电模式	
	3. 5	5 测量与过零输出功能	14
		3.5.1 测量功能	. 14
		3. 5. 2 过零输出	14
	2 6	6 校表方法	
		7_复位	
4	芯	片接口	16
	1 1	1 SPI 接口	16
	4. 1		
		4.1.1 四线模式	
		4.1.2 三线模式	
		4.1.3 超时和保护	. 18
	4 5	2 严重报警 WARNOUT 引脚	
		3 芯片与 MCU 隔离情况下的低成本功能实现	
_			
5	奇	'存器	19
	5. 1	1 寄存器列表	. 19
		2 状态和特殊寄存器	
	<b>5.</b> 3	3 计量/测量的校准和配置	
		5.3.1 计量校准和配置寄存器	
		5.3.2 测量校准寄存器	. 31
	5. 4	4 电能寄存器	36
		5 测量量寄存器	
^			
6	电	.气参数	46
	6. 1	1 技术指标	46
		2 SPI 接口时序	
		3 上电复位时序	
		4 过零信号时序	
	6. 5	5 失压时序	51
		6 脉冲输出	
		~ 旅门 偏日 7   极限参数和热特性 ....................................	
<del>}</del> _	化	「	UZ
ИJ	双1	市   加   ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	่ออ

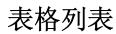




表 -1	芯片功能列表	6
表 -2	引脚说明	
表 -3	有功计量的误差	
表 -4	无功计量的误差	
表 -5	起动与潜动阈值设置	12
表 -6	电能寄存器	
表 -7	计量模式	
表 -8	芯片的测量格式	
表 -9	四线模式的读写结果	
表 -10	三线模式的读写结果	18
表 -11	寄存器列表	19
表 -12	SPI 时序特征	
表 -13	上电复位参数	
表 -14	过零信号参数	50
表 -15	失压参数	51





图 -1	90E21 功能模块图	
图 -2	90E22 功能模块图	
图 -3	90E23 功能模块图	
图 -4	90E24 功能模块图	
图 -5	产品引脚分布 ( 顶视图 )	
图 -6	四线模式的读序列	
图 -7	四线模式的写序列	
图 -8	三线模式的读序列	
图 -9	三线模式的写序列	17
图 -10	4 线 SPI 时序图	48
图 -11	3 线 SPI 时序图	48
图 -12	上电复位时序图	49
图 -13	过零时序图	
图 -14	失压时序图	
图 -15	脉冲输出宽度	51



# 高精度宽量程单相电能计量芯片

## 产品特性

## 计量特性

- · 芯片计量特性完全符合中国国家标准 GB/T17215.211-2006 (idt IEC62052-11)、GB/T17215.321-2008 (idt IEC62053-21)、GB/T 17215.323-2008 (idt IEC62053-23)的要求;芯片可应用于1级或2级单相有功电能表和2级单相无功电能表:
- · 计量动态范围 5000:1 (典型值)内,有功电能准确度优于 0.1%,无功电能准确度优于 0.2%;
- · 片上1.2V±2%电压基准源,温度系数典型值15ppm/℃;
- 在 5000:1 的动态范围内只需单点校准有功电能,无功电能不需要校准:
- 小电流情况下支持仪表常数加倍校验以节省校验时间;
- 电参量测量功能: 电压/电流有效值、平均有功/无功/ 视在功率、频率、功率因数和相角的引用误差都小于± 0.5%;
- 正反向有功/无功电能均具有独立的电能寄存器,有功/无功电能可由脉冲输出,亦可由电能寄存器读出以适应不同的应用场合;
- 可编程的起动和潜动功率阈值;
- L线和N线电流采样回路采用独立的ADC,并具有不同的回路增益;电流回路可选用锰铜或电流互感器(CT)进行采样,电压回路可选用电阻分压网络或电压互感器(PT)进行采样;
- L线和N线的计量方式可配置:防窃电模式(较大功率)、
   L模式(固定L线)、L+N模式(单相三线适用)和灵活模式(通过寄存器指定);
- 防窃电模式下,L和N线功率比较阈值可编程设置;

# 其它特性

- · 3.3V单电源供电,工作电压范围: 2.8~3.6V; 3.0~3.6V电压范围内保证芯片的计量准确度; 芯片数字输入引脚可兼容5V系统;
- 内置滞回型上电复位电路;
- 标准的 SPI 接口或简化的三线准 SPI 接口,对所有寄存器的操作均为 24 个周期:
- 具有参数校验功能和可编程中断输出功能,能输出 IRQ 中断信号和 WarnOut 报警信号;
- 具有可配置的失压检测和过零输出功能;
- 各通道输入范围:
  - 电压通道 (增益为 1 倍时): 120μVrms~600mVrms;
  - -L 线电流通道(增益为 24 倍时): 5uVrms~25mVrms:
  - -N线电流通道(增益为1倍时): 120μVrms~600mVrms;
- 可编程的 L 线电流通道增益: 1, 4, 8, 16, 24 倍; 可编程的 N 线电流通道增益: 1, 2, 4 倍;
- · 提供 L 线和 N 线的失调补偿:
- CF1和CF2分别输出有功和无功电能脉冲,可用于校表或 电能累计:
- 晶振频率: 8.192MHz; 芯片内置 10pF 电容, 无需外置电容:
- · 绿色 SSOP28 封装;
- · 工作温度范围: -40 ℃ ~+85 ℃。

## 应用

• 90E21/22/23/24 系列芯片适用于单相两线,单相三线和防窃电电能表的有功、无功电能计量。芯片具有的测量功能,亦可用于需要测量电压、电流等参量的电力仪表。

# 产品说明

90E21/22/23/24 是一款高精度宽量程的电能计量芯片, IDT 特有的 ADC 和 DSP 技术确保了芯片在电网条件和外部环境变化时也能保持长期稳定性。

#### 表 -1 芯片功能列表

芯片型号	有功计量	无功计量	N 线计量	瞬时值测量
90E21	√			√
90E22	√	√		√
90E23	√		<b>√</b>	√
90E24	√	√	√	√

90E21/22/23/24均采用绿色SS0P28封装,引脚排列一致。本文所有涉及无功计量的部分仅适用于90E22/24,涉及N线计量和测量的部分仅适用于90E23/24。

# 功能模块图

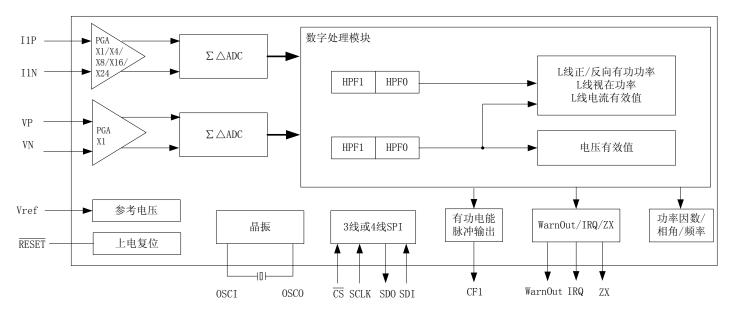


图 -1 90E21 功能模块图

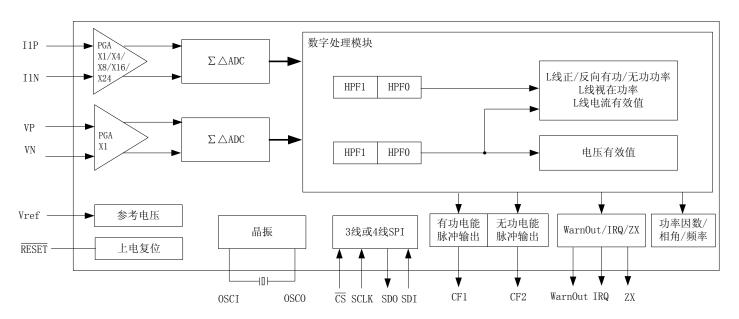


图 -2 90E22 功能模块图

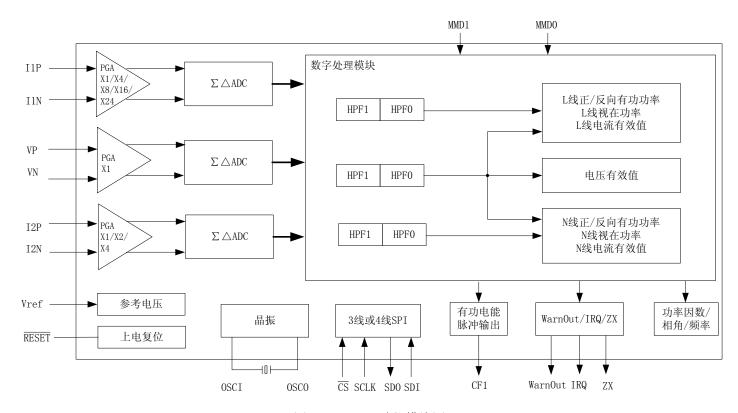


图 -3 90E23 功能模块图

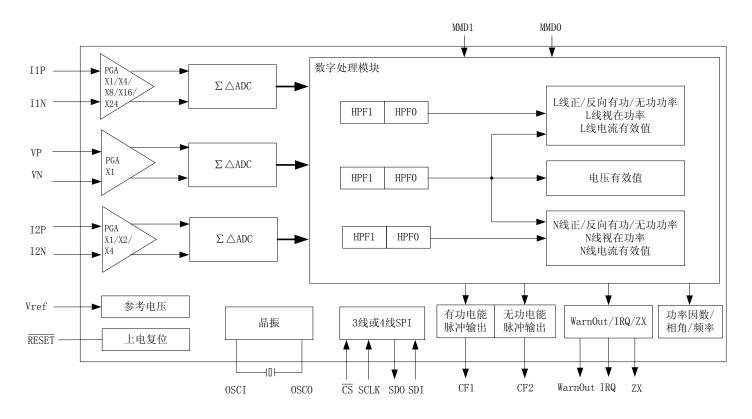


图 -4 90E24 功能模块图

# 1 引脚分布

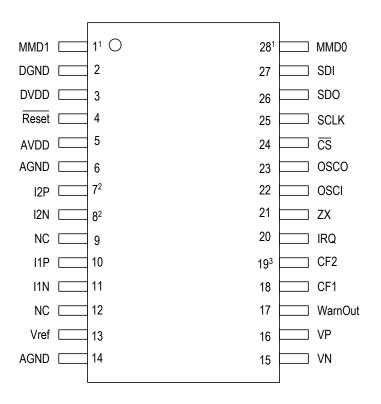


图-5 产品引脚分布(顶视图)

注1: 引脚1、28为90E23/24专用,在90E21/22中,引脚1需接DGND,引脚28需接DVDD。

注 2: 引脚 7、8 为 90E23/24 专用,在 90E21/22 中不要连接。

注 3: 引脚 19 为 90E22/24 专用,在 90E21/23 中不要连接。

# 2 引脚说明

# 表-2 引脚说明

名称	引脚编号	I/O <sup>1</sup>	类型	说明	
Reset	4	I	LVTTL	Reset: 复位 (低电平有效) 该引脚应对地接 0.1μF 电容滤波。应用中也可与 MCU 的一个输出引脚直接相连。	
DVDD	3	I	Power	DVDD: 数字电源 用于给芯片的数字部分供电。该引脚应外接10μF电解电容加0.1μF电容去耦。	
DGND	2	I	Power	DGND: 数字接地	
AVDD	5	I	Power	AVDD: 模拟电源 用于给芯片的模拟部分供电。该引脚应以一 $10\Omega$ 电阻与 DVDD 相连,并外接 $0.1\mu$ F 电容去耦。	
Vref	13	0	Analog	Vref: 1.2V <b>基准电压的输出</b> 该引脚应外接 1μF 和 1nF 电容去耦。	
AGND	6, 14	I	Power	AGND: 模拟接地	
I1P I1N	10 11	I	Analog	I1P: L 线电流信号输入正端 I1N: L 线电流信号输入负端 L 线电流差分输入。通道增益为 24 倍时,信号输入范围为 5μVrms~25mVrms。	
12P 12N	7 8	I	Analog	I2P: N 线电流信号输入正端   I2N: N 线电流信号输入负端   N 线电流差分输入。通道增益为1倍时,信号输入范围为120μVrms~600mVrms。	
VP VN	16 15	I	Analog	<b>VP:</b> 电压信号输入正端 VN: 电压信号输入负端 电压差分输入。信号输入范围为 120μVrms~600mVrms。	
NC	9, 12			NC: 不要连接。	
CS	24	I	LVTTL	<b>CS</b> : SPI <b>片选信号</b> 在标准的四线 SPI 接口模式中,每一次读写操作都必须伴随一次 <b>CS</b> 脚从高到 低的转换,并在整个读写操作过程中维持低电平。在三线 SPI 接口模式中, <b>CS</b> 脚须拉低。参见 4.1 节。	
SCLK	25	I	LVTTL	SCLK: <b>串行时钟</b> 该引脚用作 SPI 接口时钟。SDI 上的数据在 SCLK 的上升沿输入,SDO 的数据 在 SCLK 的下降沿输出。	
SDO	26	OZ	LVTTL	SDO: 申行数据输出 该引脚用作 SPI 接口数据输出。数据在 SCLK 的下降沿输出。	
SDI	27	I	LVTTL	SDI: 申行数据输入 该引脚用作 SPI 接口数据输入。地址和数据在 SCLK 的上升沿输入。	
MMD1 MMD0	1 28	I	LVTTL	MMD1/0:       配置计量模式         00:       防窃电模式 (较大功率);         01:       L 模式 (固定 L 线);         10:       L+N 模式 (单相三线适用);         11:       灵活模式 (通过 LNSe1 位 (MMode, 2BH) 指定)。         注:       MMD1/0 为 90E23/24 芯片特有引脚,在 90E21/22 中固定为 L 模式,MMD1         需接 DGND, MMD0 需接 DVDD。	
OSCI	22	I	LVTTL	OSCI: 外接晶体的输入端 在 OSCI 和 OSCO 之间应接一个频率为 8.192 MHz 的晶体。 芯片内置 10pF 电容,无需外置电容。	
OSCO	23	0	LVTTL	OSCO: 外接晶体的输出端 在 OSCI 和 OSCO 之间应接一个频率为 8. 192 MHz 的晶体。 芯片内置 10pF 电容,无需外置电容。	

# 表-2 引脚说明 (续)

名称	引脚编号	I/O <sup>1</sup>	类型	说明
CF1 CF2	18 19	0	LVTTL	CF1: 有功电能脉冲输出 CF2: 无功电能脉冲输出 有功 / 无功电能脉冲输出引脚。 注: CF2 为 90E22/24 芯片特有引脚,在 90E21/23 中不要连接。
ZX	21	0	LVTTL	ZX: 电压过零输出 电压过零时,ZX 引脚输出高电平。过零方式可由 Zxcon[1:0] 位(MMode, 2BH)配置为正过零、负过零或全过零。
IRQ	20	0	LVTTL	IRQ: 中断输出 当系统状态字寄存器(SysStatus, 01H)中一位或多位数据被置位,IRQ 输 出高电平。当系统状态字寄存器(SysStatus, 01H)中无有效置位值,IRQ 自 动恢复低电平。
WarnOut	17	0	LVTTL	WarnOut: 严重错误报警引脚 当计量参数校验错误或电压失压时,严重错误报警引脚 WarnOut 输出高电平。 参见 4. 2 节。
<b>注 1:</b> 除了 OSCI 之夕	卜,所有的数字输	ì入引脚都	兼容 5V 系统	

## 3 功能描述

## 3.1 计量动态范围

计量动态范围 5000:1 (典型值)内,有功电能计量准确度优于 0.1%,无功电能计量准确度优于 0.2%。参见表 -3 和表 -4。

## 表-3 有功计量的误差

电流	功率因数	误差 (%)
20mA ≤ I < 50mA	1.0	± 0.2
50mA ≤ I ≤ 100A	1.0	± 0.1
50mA ≤ I < 100mA	0.5 感性	± 0.2
100mA ≤ I ≤ 100A	0.8 容性	± 0.1
<b>注</b> : 锰铜电阻 250 μΩ	2, CT 电流变比 1000:	1, 负载电阻 6Ω。

## 表-4 无功计量的误差

电流	sin Φ (感性或容性)	误差(%)		
20mA ≤ I < 50mA	1.0	± 0.4		
50mA ≤ I ≤ 100A	1.0	± 0.2		
50mA ≤ I < 100mA	0.5	± 0.4		
100mA ≤ I ≤ 100A	0.0	$\pm$ 0.2		
注: 锰铜电阻 250 μΩ, CT 电流变比 1000: 1, 负载电阻 6Ω。				

# 3.2 起动与潜动功率

对于有功功率或无功功率,起动与潜动的阈值均可设置, 其相关寄存器参见表 -5:

## 表-5 起动与潜动阈值设置

阈值	寄存器
有功起动阈值	PStartTh, 27H
有功潜动阈值	PNo1Th, 28H
无功起动阈值	QStartTh, 29H
无功潜动阈值	QNo1Th, 2AH

在单位功率因数或者  $\sin \phi 为 1$  时,如果起动功率低于 20mA 对应的起动功率,芯片可在配置的起动功率所对应起动时间的 1.2 倍内起动。

芯片具有潜动状态位 Pnoload / Qnoload (EnStatus, 46H)。在有功潜动状态下,芯片不输出有功脉冲 CF1。在无功潜动状态下,芯片不输出无功脉冲 CF2。

有功的起动功率的默认值为电流等于 0.4% lb (基本电流) 和单位功率因数时所对应的功率,无功的起动功率的默认值为电流等于 0.5% lb 和  $\sin \phi$  等于 1 时所对应的功率。有功 / 无功潜动功率的默认值为 0。

## 3.3 电能寄存器

芯片提供了与有功 / 无功电能成正比的电能脉冲输出 CFx (CF1/CF2)。在电能表的系统应用中,电能的累计一般可采用 CFx 脉冲累加的方式进行。同时,芯片也具有电能寄存器,对有功和无功电能均提供了正向(感性)电能、反向(容性)电能和电能绝对值和寄存器。参见表 -6:

表-6 电能寄存器

电能	寄存器
正向有功电能	APenergy, 40H
反向有功电能	ANenergy, 41H
有功电能绝对值和	ATenergy, 42H
正向 (感性) 无功电能	RPenergy, 43H
反向 (容性) 无功电能	RNenergy, 44H
无功电能绝对值和	RTenergy, 45H

所有电能寄存器均读后清零,电能量的最小分辨率为 0.1 个 CF,即电能寄存器的一个 LSB 对应 0.1 个电能脉冲。

# 3.4 N线计量与防窃电功能

## 3.4.1 计量模式与 L、N 线电流采样增益配置

90E23 和 90E24 芯片有两个电流采样回路,具有 N 线计量与防窃电功能。芯片采用两个引脚 MMD1 和 MMD0 来配置计量方式。参见表-7。

## 表-7 计量模式

MMD1	MMDO	计量模式	CFx (CF1或CF2)输出
0	0	防窃电模式(较大功率)	CFx 代表较大功率的电能, 参见 3.4.2 节。
0	1	L 模式 (固定 L 线)	CFx 固定代表 L 线的电能。
1	0	L+N 模式(单相三线 适用)	CFx 代表 L 线和 N 线的电能算术和。
1	1	灵活模式(通过 LNSel 位(MMode, 2BH)指定)	CFx 代表指定线的电能。

90E23 和 90E24 芯片具有两个电流采样回路,可配置不同的增益系数。L 线的增益选择为: 1、4、8、16 和 24 倍,N 线的增益选择为: 1、2 和 4 倍,由 MMode 寄存器(2BH)设置。一般 L 线可选用锰铜电阻或电流互感器(CT)采样。基于隔离考虑,N 线可选用 CT 采样。暂不支持 Rogowski 线圈采样。

#### 3.4.2 防窃电模式

## 比较阈值

在防窃电模式下, L 线和 N 线功率差值的比较阈值可配置为: 1%、2%、……、12%和 12.5%、6.25%、3.125%、

1.5625%, 共 16 种选择, 由 Pthresh[3:0] 位 (MMode, 2BH) 配置, 上电默认值为 3.125%。阈值适用于有功电能, 由有功选定的 L 线和 N 线也适用于无功。

#### 比较方法

在防窃电模式下,功率差值的比较方法为:

如果当前是L线计量,当

N线有功功率 - L线有功功率 \*100% > 比较阈值 L线有功功率

则切换到N线计量,否则仍然维持L线计量。

如果当前是N线计量,当

L线有功功率 - N线有功功率 \*100% > 比较阈值 N线有功功率

则切换到 L 线计量, 否则仍然维持 N 线计量。

该方法可以自动实现阈值附近的滞回处理。上电默认采用L线计量。

## <u>功率较小时的特殊处理</u>

当功率较小时,量化误差、L 线与 N 线校表差异等常规因素可能引起功率差值超过设置的阈值。为保证 L 线和 N 线的正常起动,对于这种情况的处理方法为:

当 L 线和 N 线的功率均低于 8 倍起动功率但大于起动功率时,不再依功率差值的阈值进行判断,而是直接比较 L 线与 N 线的功率,以较大功率计量。

# 3.5 测量与过零输出功能

## 3.5.1 测量功能

芯片具有的测量量:

- 电压有效值
- 电流有效值 (L线/N线)
- · 有功平均功率(L线/N线)
- 无功平均功率 (L线/N线)
- 电压频率
- 功率因数 (L线/N线)
- 电压电流相角 (L线/N线)
- 视在平均功率 (L线/N线)

除频率外,上述测量量均采用引用误差计算,准确度等级优于 0.5级 (频率准确度优于 0.01Hz)。引用误差的计算方法如下:

引用误差 = 
$$\frac{U_{\text{mea}} - U_{\text{real}}}{U_{\text{FV}}} * 100\%$$

其中  $U_{mea}$  是电压测量值, $U_{real}$  是实际电压值, $U_{FV}$  是基准值。

芯片的测量格式遵循中国电力行业标准 DL/T645-2007 的要求,如表 -8 所列:

## 表 -8 芯片的测量格式

测量值	基准值	DL/T645 要求格式	芯片定义 格式	范围	备注
电压有效值	Un	XXX. X	XXX. XX	$0\sim655.35$ V	
电流有效值1,2	Imax 取 4Ib	XXX. XXX	XX. XXX	$0\sim65.535$ A	
有功 / 无功功率 1	最大功率 取 Un × 4Ib	XX. XXXX	XX. XXX	$-32.768 \sim +32.767$ kW/kvar	补码, MSB 为符号位;
视在功率1	Un × 4Ib	XX. XXXX	XX. XXX	$0\sim$ +32.767 kVA	补码, MSB 恒为 0;
频率	fn	XX. XX	XX. XX	$45.00 \sim 65.00 \; \mathrm{Hz}$	
功率因数 <sup>3</sup>	1.000	X. XXX	X. XXX	$-1.000 \sim +1.000$	有符号数, MSB 为符号位;
相角4	180°	XXX. X	XXX. X	−180° ~ +180°	有符号数, MSB 为符号位;

注 1: 寄存器统一为 16 位,对于电流和有功 / 无功 / 视在功率可能超过上述范围的情况,建议在应用中由 MCU 自行处理,如在校表时将寄存器值校准到实际值的 1/2,应用中再乘以 2 即可。需要注意的是,如果实际电流是芯片电流的 2 倍,则实际的有功 / 无功 / 视在功率也是芯片功率的 2 倍。

注 2: 在电流小于 15mA 时不保证准确度。注意在电流基准值是 5A,引用准确度是 0.5% 时,允许容差是 25mA。

注 3: 功率因数由有功功率除以视在功率得到。

注 4: 相角在 256KHz 的频率下,在电压 / 电流的过零点时获得。不保证在电流很小情况下的准确度。

#### 3.5.2 过零输出

采样电压信号过零时,芯片的 ZX 引脚输出高电平。过零输出方式可由 Zxcon[1:0] 位 (MMode, 2BH) 配置为正过零/负过零/全过零。参见 6.4 节。

过零信号可有助于一些操作,如典型智能电表应用中的继电器拉闸、载波发送等操作。

## 3.6 校表方法

#### 计量校准

在整个动态范围内,只需要单点校表。

计量校准先在功率因数为1时校准增益,然后在功率因数为0.5L时校准角差。

然而,由于 L 线电流采样电路信号较小,因此,任何外部干扰,如电能表电源用变压器可能引起锰铜电阻上产生几十纳伏的感应电压,会产生可觉察到的计量误差,尤其在较小电流时。对于这种近乎恒定的外部干扰信号,芯片提供了功率失调的补偿。

N 线的校准应在 L 线校准完成后进行。无功部分不需要校准。

#### 测量校准

在测量校准中,分别对电压有效值和电流有效值的增益进行校准。考虑到外部器件可能引起测量参数在零值附近的非线性,芯片还提供了电压有效值、电流有效值、有功平均功率、无功平均功率的失调补偿。

频率、相角、功率因数无需校准。

具体的校表方法可参见应用指南 AN-641。

## 3.7 复位

芯片具有滞回比较器式片上电源监测电路,在规定的电压 范围内芯片才能正常工作。

芯片具有三种复位方式:上电复位、硬件复位和软件复位。复位后寄存器恢复到上电默认值。

上电复位:上电时,芯片自动上电复位。参见6.3节。

硬件复位:芯片具有外部复位引脚 Reset, Reset 信号低电平有效,低电平脉冲长度应大于 200µs。

软件复位:芯片具有软件复位寄存器(SoftReset,00H),向该寄存器写入789AH,芯片即自动复位。

## 4 芯片接口

## 4.1 SPI 接口

SPI 是一种全双工、同步的通信总线。芯片支持两种 SPI 模式: 四线模式或三线模式。四线模式使用四个引脚: CS、SCLK、SDI 和 SDO。三线模式使用三个引脚: SCLK、SDI 和 SDO。SDI 引脚的数据在 SCLK 的上升沿输入,SDO 引脚的数据在 SCLK 的下降沿输出。LastSPIData 寄存器 (06H) 存放有最近一次读写的 16 位数据。

#### 4.1.1 四线模式

在标准四线模式中, CS 引脚在整个读写过程中必须置低。

## 读序列

如图 -6 所示,首先 SDI 置高标志为读操作,随后 SDI 上输入 7 位寄存器地址,然后该寄存器内 16 位数据在 SDO 上输出。一个完整的读操作包含 24 个 SCLK 周期。

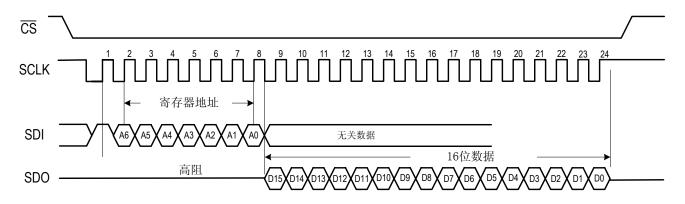


图-6 四线模式的读序列

## <u>写序列</u>

如图 -7 所示,首先 SDI 置低标志为写操作,随后 SDI 上输入 7 位寄存器地址,然后输入 16 位数据。一个完整的写操作包含 24 个 SCLK 周期。

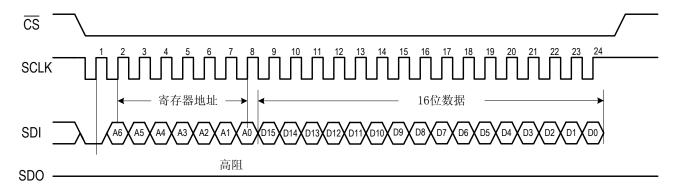


图 -7 四线模式的写序列

芯片接口 16 2010 年 9 月 3 日

#### 4.1.2 三线模式

在三线模式下, CS 引脚持续低电平。当没有任何操作时, SCLK 保持高电平。如果 SCLK 信号保持低电平 400μs 以上, 会触发读写操作。随后的读写操作与四线模式类似。参见图 -8 和图 -9。

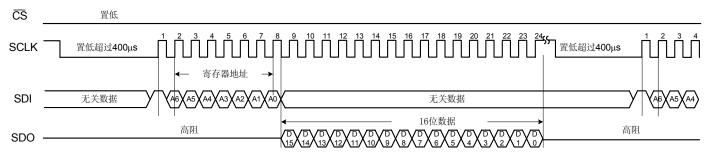


图 -8 三线模式的读序列

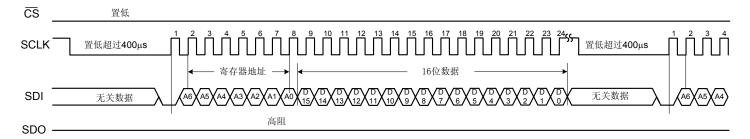


图-9 三线模式的写序列

#### 4.1.3 超时和保护

无论三线还是四线模式,如果 SCLK 保持不变超过 6ms 即为超时,读写操作会中止。

如果 CS 置低 (四线模式下)或者两个开始指令之间 (三线模式下)超过 24 个 SCLK 周期,写操作会不使能,读操作会取前 24 个 SCLK 周期完成。但读取结果可能不正确。

在读操作时,如果地址无效,读出值为全 0。在写操作时,如果地址无效,没有任何寄存器会被写入。

表 -9 和表 -10 列出了各种情况下的读写结果:

#### 表-9 四线模式的读写结果

	条件		结果		
操作	超时	SCLK 周期数 <sup>1</sup>	读写操作	LastSPIData 寄存器更新	
读	_2 >=24		读	是	
以	_2	<24	部分读	否	
	无	=24	写	是	
写	无	!=24	不写	否	
	有	_	不写	否	

**注 1**: SCLK 周期数是指 **CS** 置低期间的 SCLK 周期数或者超时前的 SCLK 周期数。

注 2: - 表示不论超时与否。

#### 表-10 三线模式的读写结果

	条件		结果			
操作	超时	SCLK 周期数 <sup>1</sup>	读写操作	LastSPIData 寄存器更新		
	无	>=24 <sup>2</sup>	读	是		
	24 周期后 超时	>24	读	是		
读	24 周期前 超时	_3	部分读	否		
	24 周期时 超时	=24	读	是		
	无	=24	写	是		
写	无	!=24	不写	否		
	有	_	不写	否		

注 1: SCLK 周期数是指两个开始指令之间的 SCLK 周期数或者超时前的 SCLK 周期数。

**注 2**: 在三线模式,没有超时的情况下,不存在小于 24 个 SCLK 周期的情况,因为下一个操作的前几个 SCLK 周期会被算进这次操作。这种情况下,数据被毁坏。

注 3: - 表示无关数据。

## 4.2 严重报警 WARNOUT 引脚

芯片在两种情况下会通过 WarnOut 引脚发出严重报警:校验错误和失压。

#### 校验错误

对于校表参数、计量配置等重要参数,芯片采用定期自动校验的方式实现芯片的可靠运行。在校验不正确时,CalErr[1:0] 位(SysStatus,01H)被置位,同时 WarnOut引脚输出高电平,IRQ 引脚也输出高电平。计量部分不工作以防止上电时刻产生大量脉冲或在不正确参数下出现异常情况。

## 失压

在任意过零点开始的一个周期内,如果电压持续低于失压 阈值,则认为发生失压。失压阈值由 SagTh 寄存器 (03H) 配置,参见 6.5 节。

当失压发生,SagWarn 位(SysStatus,01H)被置位,如果 FuncEn 寄存器(02H)允许失压通过 WarnOut 引脚报警,则该引脚输出高电平。该功能有助于减少系统应用中的掉电检测电路。同时,芯片采用检测交流侧电压的方式判断失压,消除了传统方法中整流电路中大电容的影响,可更早检测到失压的发生。

## 4.3 芯片与 MCU 隔离情况下的低成本功能实现

在芯片与MCU隔离情况下,以下功能的低成本实现方式为:

SPI: 在芯片与 MCU 隔离情况下, MCU 可以通过低速光耦 (例如NEC2501)完成读写操作。SPI接口可以是3线或者4线。

电能脉冲 CFx: 电能可以通过读取相应电能寄存器中的电能值进行累计。CFx 也可直接连接至光耦用于校表,电能脉冲指示灯由 CFx 点亮。

严重报警 WarnOut: 严重报警信息可通过读取 CalErr[1:0] 位(SysStatus, 01H)的状态来获得。

中断 IRQ: 中断信号可通过读取 SysStatus 寄存器 (01) 获得。

复位:将 789AH 写入复位寄存器(SoftReset,00H)可使芯片软件复位。

# 5 寄存器

# 5.1 寄存器列表

# 表-11 寄存器列表

寄存器 地址	寄存器名称	读写类型	功能说明	说明 <sup>1</sup>	所在页码
<u> </u>		1	状态和特殊寄存器		
00Н	SoftReset	写	软件复位		P 20
01H	SysStatus	读后清	系统状态字	各芯片有所不同 <sup>2,3</sup>	P 21
02H	FuncEn	读/写	功能起动	各芯片有所不同 <sup>2</sup>	P 22
03Н	SagTh	读/写	失压阈值设置		P 22
04H	SmallPMod	读/写	小功率模式		P 23
06Н	LastSPIData	读	上一次读 / 写 SPI 的值		P 23
			计量校准和配置寄存器		
20H	CalStart	读/写	计量参数校准起动命令		P 24
21H	PLconstH	读/写	高频脉冲常数高字		P 24
22H	PLconstL	读/写	高频脉冲常数低字		P 25
23Н	Lgain	读/写	L线校表增益		P 25
24H	Lphi	读/写	L线校表角差		P 25
25H	Ngain	读/写	N线校表增益	90E21/22 不适用 <sup>3</sup>	P 26
26H	Nphi	读/写	N线校表角差	90E21/22 不适用 <sup>3</sup>	P 26
27H	PStartTh	读/写	有功起动功率阈值		P 26
28H	PNo1Th	读/写	有功潜动功率阈值		P 27
29Н	QStartTh	QStartTh 读 / 写 无功起动功率阈值 90E21/23 不适用 <sup>2</sup>		P 27	
2AH	QNo1Th	读/写	无功潜动功率阈值	90E21/23 不适用 <sup>2</sup>	P 27
2BH	MMode	读/写	计量模式配置	各芯片有所不同 <sup>2,3</sup>	P 28
2CH	CS1	读/写	校验码1		P 30
<u>'</u>		1	测量校准寄存器		<b>.</b>
30H	AdjStart	读/写	测量参数校准起动命令		P 31
31H	Ugain	读/写	电压有效值增益		P 31
32H	IgainL	读/写	L线电流有效值增益		P 32
33H	IgainN	读/写	N线电流有效值增益	90E21/22 不适用 <sup>3</sup>	P 32
34H	Uoffset	读/写	电压失调		P 32
35H	IoffsetL	读/写	L线电流失调		P 33
36H	IoffsetN	读/写	N线电流失调	90E21/22 不适用 <sup>3</sup>	P 33
37H	PoffsetL	读/写	L线有功功率失调		P 33
38H	QoffsetL	读/写	L线无功功率失调	90E21/23 不适用 <sup>2</sup>	P 34
39Н	PoffsetN	读/写	N线有功功率失调	90E21/22 不适用 <sup>3</sup>	P 34
ЗАН	QoffsetN	读/写	N线无功功率失调	90E21/22/23 不适用 <sup>2, 3</sup>	P 34
ЗВН	CS2	读/写	校验码 2		P 35
•			电能寄存器		
40H	APenergy	读后清	正向有功电能		P 36
41H	ANenergy	读后清	反向有功电能		P 36
42H	ATenergy	读后清	有功电能绝对值和		P 37
43H	RPenergy	读后清	正向 (感性) 无功电能	90E21/23 不适用 <sup>2</sup>	P 37
44H	RNenergy	读后清	反向 (容性) 无功电能	90E21/23 不适用 <sup>2</sup>	P 37

## 表-11 寄存器列表 (续)

寄存器 地址	寄存器名称	读写类型	功能说明	说明 <sup>1</sup>	所在页码
45H	RTenergy	读后清	无功电能绝对值和	90E21/23 不适用 <sup>2</sup>	P 38
46H	EnStatus	读	计量状态	各芯片有所不同 2,3	P 39
			测量量寄存器		•
48H	Irms	读	L线电流有效值		P 40
49H	Urms	读	电压有效值		P 40
4AH	Pmean	nean 读 L线有功平均功率			P 41
4BH	Qmean	读	L线无功平均功率	90E21/23 不适用 <sup>2</sup>	P 41
4CH	Freq	读	电压频率		P 41
4DH	PowerF	读	L线功率因数		P 42
4EH	Pangle	读	L线电压电流相角		P 42
4FH	Smean	读	L线视在平均功率		P 42
68H	Irms2	读	N线电流有效值	90E21/22 不适用 <sup>3</sup>	P 43
6AH	Pmean2	读	N线有功平均功率	90E21/22 不适用 <sup>3</sup>	P 43
6BH	Qmean2	读	N线无功平均功率	90E21/22/23 不适用 <sup>2, 3</sup>	P 44
6DH	PowerF2	读	N线功率因数	90E21/22 不适用 <sup>3</sup>	P 44
6ЕН	Pangle2	读	N线电压电流相角	90E21/22 不适用 <sup>3</sup>	P 44
6FH	Smean2	读	N线视在平均功率	90E21/22 不适用 <sup>3</sup>	P 45

注 1: 本寄存器列表为 90E24 所具有的寄存器;

注 2: 该寄存器为涉及无功电能的寄存器。90E21/23 不具有无功,因此该寄存器涉及无功的部分将无效;

注 3: 该寄存器为涉及 N 线的寄存器, 90E21/22 芯片不具有 N 线, 因此该寄存器涉及 N 线的部分将无效。

# 5.2 状态和特殊寄存器

## SoftReset 软件复位

类	址: 00H 型: 写 认值: 0000	)H							
	15	14		13	12	11	10	9	8
	SoftReset	15 SoftRese	t14	SoftReset13	SoftReset12	SoftReset11	SoftReset10	SoftReset9	SoftReset8
	7	6		5	4	3	2	1	0
	SoftReset7 SoftRese		et6	SoftReset5	SoftReset4	SoftReset3	SoftReset2	SoftReset1	SoftReset0
位名称描述									
	15-0 SoftReset[15:0] 软件复位寄存器,写入 789AH,可软件复位芯片,写入其它值无效。								

## SysStatus 系统状态字

地址: 01H 类型: 读后清 默认值: 0000								
15	14	13	12	11	10	9	8	
CalErr1	CalErro	O AdjErr1	AdjErr0	_	-	-	_	
7	6	5	4	3	2	1	0	
LNchange	RevQch	g RevPchg	_	_	_	SagWarn	_	
位	 名称				<u></u>			
15 - 14	CalErr[1:0]	CS1 校验状态。 00: CS1 校验正确( 11: CS1 校验错误,『		<b></b> 脚输出高电平				
13 - 12	AdjErr[1:0]	CS2 校验状态。 00: CS2 校验正确( 11: CS2 校验错误	0: CS2 校验正确 (默认)					
11 - 8	-	保留位。						
7	LNchange	计量线路 (L线和N) 0: 无改变 (默认) 1: 改变	线)有无改变。					
6	RevQchq	无功电能方向有无改 0:无改变(默认) 1:改变 该状态位的使能位为		cEn, 02H).				
5	RevPchg	有功电能方向有无改 0:无改变(默认) 1:改变 该状态位的使能位为		ocEn, 02H).				
4 - 2	-	保留位。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
1	SagWarn	失压状态。 0: 无失压 (默认) 1: 失压 失压中断的使能位为 SagEn 位 (FuncEn, 02H)。 失压通过 WarnOut 引脚报警的使能位为 SagWo 位 (FuncEn, 02H)。						
0	-							
<b>注</b> :上述任何	事件的发生都会	促使 IRQ 引脚输出高时	电平产生中断。					

# FuncEn 功能启动

地址: 02H 类型: 读/写 默认值: 0000	CH CH							
15	14	13	12	11	10	9	8	
_	_	-	-	-	-	_	_	
7	6	5	4	3	2	1	0	
_	_	SagEn	SagWo	RevQEn	RevPEn	_	_	
位	名称		描述					
15 - 6	-	保留位。						
5	SagEn	失压中断使能。 0: 不使能 (默认) 1: 使能						
4	SagWo	失压通过 WarnOut 引 0: 不使能(默认) 1: 使能	脚报警使能。					
3	RevQEn	无功电能方向发生改 0:不使能 1:使能(默认)						
2	RevPEn	有功电能方向发生改 0:不使能 1:使能(默认)	有功电能方向发生改变中断使能。 :不使能					
1 - 0	-	保留位。						

## SagTh 失压阈值设置

址: 03H 型:读/写									
默认值: 1D6AH									
15	14	13	12	11	10	9	8		
SagTh15	SagTh1	4 SagTh13	SagTh12	SagTh11	SagTh10	SagTh9	SagTh8		
7	6	5	4	3	2	1	0		
SagTh7	SagTh6	SagTh5	SagTh4	SagTh3	SagTh2	SagTh1	SagTh0		
位	名称				<u></u>				
15-0SagTh15 - SagTh0失压阈值设置。数据格式为 XXX. XX,单位为 V。 SagTh 的上电默认值取 22000*sqrt (2)*0. 78/(4*Ugain/32768),对应 1D6AH。 具体的设置方法可参见应用指南 AN-641。									

## SmallPMod 小功率模式

き	也址: 04H 类型: 读 / 写 犬认值: 0000								
	15	14		13	12	11	10	9	8
	SmallPMod	15 SmallPMc	d14	SmallPMod13	SmallPMod12	SmallPMod11	SmallPMod10	SmallPMod9	SmallPMod8
	7 6			5	4	3	2	1	0
	SmallPMod	17 SmallPM	od6	SmallPMod5	SmallPMod4	SmallPMod3	SmallPMod2	SmallPMod1	SmallPMod0
	位	名称				描述	<u></u> 龙		
	15-0 SmallPMod15-SmallPMod0 小功率模式起动命令。 A987H: 小功率模式。在此模式下,L线和N线有功/无功功率寄存器值与正常模式下的功率的关系为: 正常模式功率 = 小功率模式下功率 *10*Igain*Ugain /2^42 其它值: 正常模式。						力功率的关系为:		

## LastSPIData 上一次读 / 写 SPI 的值

		O. 1 H.) IE								
类	地址: 06H 类型: 读 默认值: 0000H									
	15	14	13	12	11	10	9	8		
	LastSPIData	15 LastSPIDat	a14 LastSPIData13	LastSPIData12	LastSPIData11	LastSPIData10	LastSPIData9	LastSPIData8		
	7	6	5	4	3	2	1	0		
	LastSPIData	a7 LastSPIDa	ta6 LastSPIData5	LastSPIData4	LastSPIData3	LastSPIData2	LastSPIData1	LastSPIData0		
	位	名称		描述						
	15 - 0	LastSPIData15 - LastSPIData0	该寄存器存放 SPI 接	该寄存器存放 SPI 接口最新一次读写的数据。参见表 -9 和表 -10。						

# 5.3 计量/测量的校准和配置

# 5.3.1 计量校准和配置寄存器

## CalStart 计量参数校准起动命令

地址: 20H 类型:读/写 默认值: 6886							
15	14	13	12	11	10	9	8
CalStart1	5 CalStart	t14 CalStart13	CalStart12	CalStart11	CalStart10	CalStart9	CalStart8
7	6	5	4	3	2	1	0
CalStart'	7 CalStar	t6 CalStart5	CalStart4	CalStart3	CalStart2	CalStart1	CalStart0
位	名称				<b>述</b>		<del>_</del>
15 - 0	计量参数校准起动命令: 6886H: 上电默认值,不计量。 5678H: 计量校准起始命令。写入 5678H 后即将 21H-2BH 寄存器恢复到上电默认值,芯片开始计量并输出电						

# PLconstH 高频脉冲常数高字

类	地址: 21H 类型: 读/写 默认值: 0015H										
	15		14		13	12	11	10	9	8	
	PLconstH1	5	PLconstH	14	PLconstH13	PLconstH12	PLconstH11	PLconstH10	PLconstH9	PLconstH8	
	7		6		5	4	3	2	1	0	
	PLconstH7	7	PLconstl	H6	PLconstH5	PLconstH4	PLconstH3	PLconstH2	PLconstH1	PLconstH0	
	位		名称	描述							
PLconstH[15:0] 和 PLconstL[15:0] 分别为高频脉冲常数的高字和低 PL_Constant 是一个常数,它与电压电流采样比率成正比,与电表常数 能累计的阈值,即芯片内部累计的电能大于 PL_Constant 就会累计在 建议PLconst的设置值为4的整数倍。在小电流状态下把电表常数加倍在 PLconstL 设置完成后才有效。 具体的计算方法可参见应用指南 AN-641。						比,与电表常数A ant 就会累计在相	发反比。 PL_Cons l应的电能寄存器	并经由 CFx 输出。			

## PLconstL 高频脉冲常数低字

类	业: 22H 型: 读 / 写 认值: D174							
	15	14	13	12	11	10	9	8
	PLconstL1	5 PLconstL	PLconstL13	PLconstL12	PLconstL11	PLconstL10	PLconstL9	PLconstL8
	7	6	5	4	3	2	1	0
	PLconstL	7 PLconstl	L6 PLconstL5	PLconstL4	PLconstL3	PLconstL2	PLconstL1	PLconstL0
位名称描述								
15-0       PLconstL[15:0]       PLconstH[15:0]       和 PLconstL[15:0]       分别为高频脉冲常数的高字和低字。         建议 PLconst 的设置值为 4 的整数倍。具体的计算方法可参见应用指南 AN-641。								

# Lgain L 线校表增益

	地址: 23H 类型: 读/写 默认值: 0000H											
15	14	13	12	11	10	9	8					
Lgain15	Lgain1	4 Lgain13	Lgain12	Lgain11	Lgain10	Lgain9	Lgain8					
7	6	5	4	3	2	1	0					
Lgain7	Lgain	S Lgain5	Lgain4	Lgain3	Lgain2	Lgain1	Lgain0					
位	名称			描述	<u></u>							
15-0 Lgain[15:0] L线校表增益,具体的计算方法可参见应用指南 AN-641。												

## Lphi L 线校表角差

类型	b址: 24H é型: 读/写 术认值: 0000H										
	15	14		13	12		11	10	9	8	
	Lphi15	_		-	_		-	_	Lphi9	Lphi8	
	7	6		5	4		3	2	1	0	
	Lphi7	Lphi6	L	phi5	Lphi4		Lphi3	Lphi2	Lphi1	Lphi0	
	位	名称						 述			
15-0 Lphi[15:0] L线校表角差,具体的计算方法可参					可参见	上应用指南 AN-64	41.				

## Ngain N 线校表增益

地址: 25H 类型:读/写 默认值: 0000							
15	14	13	12	11	10	9	8
Ngain15	Ngain1	4 Ngain13	Ngain12	Ngain11	Ngain10	Ngain9	Ngain8
7	6	5	4	3	2	1	0
Ngain7	Ngain6	Ngain5	Ngain4	Ngain3	Ngain2	Ngain1	Ngain0
位	名称				 述		
15-0 Ngain[15:0] N 线校表增益,具体的计算方法可参见应用指南 AN-641。							

# Nphi N 线校表角差

类型:	地址: 26H 类型:读/写 默认值: 0000H										
	15	14	13	12	11	10	9	8			
	Nphi15	_	_	_	_	_	Nphi9	Nphi8			
	7	6	5	4	3	2	1	0			
	Nphi7	Nphi6	Nphi5	Nphi4	Nphi3	Nphi2	Nphi1	Nphi0			
,	位	名称	描述								
15-0 Nphi[15:0] N 线校表角差,具体的计算方法可参见应用指南 AN-641。											

# PStartTh 有功起动功率阈值

类型	上: 27H 型: 读 / 写 人值: 08BD							
	15	14	13	12	11	10	9	8
	PStartTh1	5 PStartTh	PStartTh13	PStartTh12	PStartTh11	PStartTh10	PStartTh9	PStartTh8
	7	6	5	4	3	2	1	0
	PStartTh7	7 PStartT	h6 PStartTh5	PStartTh4	PStartTh3	PStartTh2	PStartTh1	PStartTh0
	位	名称			描述	<u></u>		
15-0 PStartTh[15:0] 有功起动功率阈值,具体的计算方法可参见应用指南 AN-641。								

## PNolTh 有功潜动功率阈值

地址: 28H 类型:读/写 默认值: 0000							
15	14	13	12	11	10	9	8
PNo1Th15	PNo1Th1	4 PNo1Th13	PNo1Th12	PNolTh11	PNo1Th10	PNo1Th9	PNo1Th8
7	6	5	4	3	2	1	0
PNo1Th7	PNo1Th(	6 PNo1Th5	PNo1Th4	PNo1Th3	PNo1Th2	PNo1Th1	PNo1Th0
位                     描述							
15-0 PNoITh[15:0] 有功潜动功率阈值,具体的计算方法可参见应用指南 AN-641。							

## QStartTh 无功起动功率阈值

地址: 29H 类型: 读/写 默认值: 0AEG								
15	14	13	12	11	10	9	8	
QStartTh	15 QStartTh	QStartTh13	QStartTh12	QStartTh11	QStartTh10	QStartTh9	QStartTh8	
7	6	5	4	3	2	1	0	
QStartTh	7 QStartTl	h6 QStartTh5	QStartTh4	QStartTh3	QStartTh2	QStartTh1	QStartTh0	
位                     描述								
15 - 0	QStartTh[15:0]	无功起动功率阈值,	具体的计算方法	可参见应用指南月	AN-641.			

## QNolTh 无功潜动功率阈值

地址: 2AH 类型: 读/写 默认值: 0000									
15	14	13	12	11	10	9	8		
QNo1Th15	QNo1Th1	.4 QNo1Th13	QNo1Th12	QNolTh11	QNolTh10	QNo1Th9	QNo1Th8		
7	6	5	4	3	2	1	0		
QNo1Th7	QNo1Th	6 QNo1Th5	QNo1Th4	QNo1Th3	QNo1Th2	QNo1Th1	QNo1Th0		
							_		
位	名称		描述						
15-0 QNoITh[15:0] 无功潜动功率阈值,具体的计算方法可参见应用指南 AN-6									

#### MMode 计量模式配置

地址: 2BH 类型:读/写 默认值: 9422H 15 14 13 12 11 10 9 8 DisHPF0 LNSe1 DisHPF1 Lgain2 Lgain1 Lgain0 Ngain1 Ngain0 7 6 5 3 2 0 1 ZXCon1 Pthresh2 Rmod ZXCon0 Pthresh3 Pthresh1 Pthresh0 Amod 描述 位 名称 L 线电流通道增益设置,默认值为 100 电流通道增益 Lgain2 Lgain1 Lgain0 15 - 13 Lgain[2:0] 1倍 0 0 0 0 1 8倍 0 0 16 倍 24 倍 N线电流通道增益设置 00:2倍 12 - 11 Ngain[1:0] 01:4倍 10: 1倍 (默认值) 11: 1倍 当计量模式由 MMD1 和 MMD0 引脚设置为灵活模式时,由该位选择当前计量线 **LNSel** 10 0: N线 1: L线 (默认值) ADC 后高通滤波器 HFP 的配置。每通道具有两个串联的一阶高通滤波器 HPF1 和 HPF0, 所有通道的 HFP 配置 相同: DisHPF[1:0] 9 - 8 DisHPF1 DisHPF 0 高通滤波器配置 0 使能 HPF1 和 HPF0 (默认值) 0 使能 HPF1,不使能 HPF0 不使能 HPF1,使能 HPF0 不使能 HPF1 和 HPF0 0 1 0 有功脉冲 CF1 输出方式: 7 Amod 0: 正向或反向电能脉冲输出 (默认值) 1: 电能绝对值和脉冲输出 无功脉冲 CF2 输出方式: 6 Rmod 0: 正向(感性)或反向(容性)电能脉冲输出(默认值) 1: 电能绝对值和脉冲输出

5 - 4	Zxcon[1:0]	00: 正过零 01: 负过零 10: 全过零, 周 11: 不输出过零									
		的切电快八个品	Pthresh3	Pthresh2	Pthresh1	Pthresh0	功率比较阈值				
			0 0	0	0 0	1 0	12.5% 6.25% 3.125% (默认值)				
			0	0	1	1	1. 5625%				
			0	1	0	0	1%				
3 - 0	Pthresh[3:0]		0	1	0	1	2%				
			0	1	1	0	3%				
			0	1	1	1	4%				
			1	0	0	0	5% 6%				
			1	0	1	0	7%				
			1	0	1	1	8%				
			1	ī	0	0	9%				
			1	1	0	1	10%				
			1	1	1	0	11%				
			1	1	1	1	12%				

## CS1 校验码 1

地址: 2CH 类型:读/写 默认值: 0000H 15 14 13 12 11 10 9 8 CS1\_15 CS1\_14 CS1\_13 CS1\_12 CS1\_11 CS1\_10 CS1 9 CS1 8 7 6 5 3 2 1 0 CS1\_7 CS1\_3 CS1\_2 CS1\_1 CS1\_0 CS1\_6 CS1\_5 CS1\_4 名称 描述 位 CS1 寄存器需在 21H-2BH 寄存器配置完成后写入。假设 21H-2BH 寄存器的高字和低字如下表所示: 寄存器地址 高字 低字 H<sub>21</sub> L<sub>21</sub> 21H H<sub>22</sub> 22H  $L_{22}$ H<sub>23</sub> 23H L<sub>23</sub> H<sub>24</sub> 24H L<sub>24</sub> H<sub>25</sub>  $L_{25}$ 25H H<sub>26</sub> L<sub>26</sub> 26H 27H H<sub>27</sub> L<sub>27</sub> 15 - 0 CS1[15:0] H<sub>28</sub> L<sub>28</sub> 28H 29H H<sub>29</sub> L<sub>29</sub> 2AH H<sub>2A</sub> L<sub>2A</sub> H<sub>2B</sub> L<sub>2B</sub> 2BH CS1 寄存器值的计算方法如下: 2CH 寄存器低字: L<sub>2C</sub>=MOD(H<sub>21</sub>+H<sub>22</sub>+...+H<sub>2B</sub>+L<sub>21</sub>+L<sub>22</sub>+...+L<sub>2B</sub>, 2^8), MOD 为取模 2CH 寄存器高字: H<sub>2C</sub>=H<sub>21</sub> XOR H<sub>22</sub> XOR ... XOR H<sub>2B</sub> XOR L<sub>21</sub> XOR L<sub>22</sub> XOR ... XOR L<sub>2B</sub>,XOR 为异或 芯片定期计算 CS1 值。如果 CS1 寄存器值与芯片计算的 CS1 值不一致且 CalStart 寄存器值为 8765H,则 CalErr[1:0] 位 (SysStatus, 01H) 置位,同时 WarnOut 和 IRQ 引脚输出高电平。

注: CS1 寄存器的读出值为芯片计算值,与芯片被写入的值不同。

# 5.3.2 测量校准寄存器

## AdjStart 测量参数校准起动命令

类	□址: 30H 陸型: 读 / 写 代认值: 6886							
	15	14	13	12	11	10	9	8
	AdjStart1	5 AdjStart	AdjStart13	AdjStart12	AdjStart11	AdjStart10	AdjStart9	AdjStart8
	7	6	5	4	3	2	1	0
	AdjStart'	7 AdjStar	t6 AdjStart5	AdjStart4	AdjStart3	AdjStart2	AdjStart1	AdjStart0
	位	名称				述		
测量参数校准起动命令: 6886H: 上电默认值,芯片不测量; 5678H: 测量参数校准起动命令。写入 5678H 后即将 31H-3AH 寄存器恢复到上电默认值,芯片开 不校核参数的正确性。AdjErr[1:0] 位 (SysStatus, 01H) 不置位也不产生 IRQ 中断; 8765H: 自动校核 31H-3AH 寄存器数据的正确性。如果正确,则正常测量;如果不正确, AdjErr[1:0] 位 (SysStatus, 01H) 置位并产生 IRQ 中断; 其它值:芯片不测量。AdjErr[1:0] 位 (SysStatus, 01H) 置位并产生 IRQ 中断。								中断;

# Ugain 电压有效值增益

地址: 31H 类型: 读/写 默认值: 6720							
15	14	13	12	11	10	9	8
Ugain15	Ugain1	4 Ugain13	Ugain12	Ugain11	Ugain10	Ugain9	Ugain8
7	7 6		4	3	2	1	0
Ugain7	Ugain6	Ugain5	Ugain4	Ugain3	Ugain2	Ugain1	Ugain0
位名称描述							
15-0 Ugain[15:0] 电压有效值增益,具体的计算方法可参见应用指南 AN-641。 注: Ugain15 只能写 0。							

## 90E21/22/23/24 数据手册

## IgainL L 线电流有效值增益

地址: 32H 类型:读/写 默认值: 7A13							
15	14	13	12	11	10	9	8
IgainL15	i IgainL	14 IgainL13	IgainL12	IgainL11	IgainL10	IgainL9	IgainL8
7	6	5	4	3	2	1	0
IgainL7	IgainL	6 IgainL5	IgainL4	IgainL3	IgainL2	IgainL1	IgainL0
位	名称				述		
15 - 0	lgainL[15:0]	L线电流有效值增益	益,具体的计算方法	法可参见应用指南	₹ AN-641.		

## IgainN N线电流有效值增益

地址: 33H 类型:读/写 默认值: 7530								
15	14	13	12	11	10	9	8	
IgainN15	i IgainN1	.4 IgainN13	IgainN12	IgainN11	IgainN10	IgainN9	IgainN8	
7	6	5	4	3	2	1	0	
IgainN7	IgainN	6 IgainN5	IgainN4	IgainN3	IgainN2	IgainN1	IgainNO	
位	名称			描述	<b>赴</b>			
15 - 0	IgainN[15:0]	线电流有效值增益,具体的计算方法可参见应用指南 AN-641。						

## Uoffset 电压失调

类型	: 34H : 读/写 值: 0000									
	15		14		13	12	11	10	9	8
	Uoffset15	5	Uoffset	14	Uoffset13	Uoffset12	Uoffset11	Uoffset10	Uoffset9	Uoffset8
	7		6		5	4	3	2	1	0
	Uoffset7	,	Uoffset	6	Uoffset5	Uoffset4	Uoffset3	Uoffset2	Uoffset1	Uoffset0
	位		名称				描述	<u></u>		
	15 - 0	Ud	offset[15:0]	电压失调,具体的计算方法可参见应用指南 AN-641。						

# IoffsetL L 线电流失调

地址: 35H 类型:读/写 默认值: 0000									
15	14	13	12	11	10	9	8		
IoffsetL1	l5   IoffsetI	L14   IoffsetL13	IoffsetL12	IoffsetL11	IoffsetL10	IoffsetL9	IoffsetL8		
7	6	5	4	3	2	1	0		
IoffsetL	7 Ioffset	L6 IoffsetL5	IoffsetL4	IoffsetL3	IoffsetL2	IoffsetL1	IoffsetL0		
位	名称			描述	**************************************				
15 - 0	loffsetL[15:0]	1. 从中次上进 目标	线电流失调,具体的计算方法可参见应用指南 AN-641。						

# IoffsetN N线电流失调

地址: 36H 类型: 读/写 默认值: 0000									
15	14	1	3	12	11	10	9	8	
IoffsetN	15 Ioffsetl	N14   Ioffs	etN13	IoffsetN12	IoffsetN11	IoffsetN10	IoffsetN9	IoffsetN8	
7	6	Ę	5	4	3	2	1	0	
IoffsetN	I7 Ioffset	N6 Ioffs	setN5	IoffsetN4	IoffsetN3	IoffsetN2	IoffsetN1	IoffsetNO	
位	名称	描述							
15 - 0	IoffsetN[15:0]	N线电流失调	N 线电流失调,具体的计算方法可参见应用指南 AN-641。						

## PoffsetL L 线有功功率失调

地址: 37H 类型:读/写 默认值: 0000							
15	14	13	12	11	10	9	8
PoffsetL1	.5 PoffsetI	L14 PoffsetL13	PoffsetL12	PoffsetL11	PoffsetL10	PoffsetL9	PoffsetL8
7	6	5	4	3	2	1	0
PoffsetL	7 Poffset	L6 PoffsetL5	PoffsetL4	PoffsetL3	PoffsetL2	PoffsetL1	PoffsetL0
位	名称	描述					
15 - 0	PoffsetL[15:0]	L 线有功功率失调。 补码,MSB 为符号位。	。具体的计算方法	去可参见应用指南	Ĩ AN−641。		

## QoffsetL L 线无功功率失调

类	2址: 38H 5型: 读 / 写 3认值: 0000									
	15	14		13	12	11	10	9	8	
	QoffsetL1	5 Qoffset	L14	QoffsetL13	QoffsetL12	QoffsetL11	QoffsetL10	QoffsetL9	QoffsetL8	
	7	6		5	4	3	2	1	0	
	QoffsetL	7 Qoffse	tL6	QoffsetL5	QoffsetL4	QoffsetL3	QoffsetL2	QoffsetL1	QoffsetL0	
	位	名称								
	15 - 0	5 - 0 QoffsetL[15:0] L 线无功功率失调。 补码,MSB 为符号位。具体的计算方法可参见应用指南 AN-641。								

## PoffsetN N线有功功率失调

类	址: 39H <sup> </sup> 型: 读 / 写   认值: 0000								
	15	14		13	12	11	10	9	8
	PoffsetN15 PoffsetN1			PoffsetN13	PoffsetN12	PoffsetN11	PoffsetN10	PoffsetN9	PoffsetN8
	7 6			5	4	3	2	1	0
	PoffsetN	7 Poffs	etN6	PoffsetN5	PoffsetN4	PoffsetN3	PoffsetN2	PoffsetN1	PoffsetNO
	位	名称							
	15 - 0	PoffsetN[15:0	PoffsetN[15:0] N 线有功功率失调。 补码,MSB 为符号位。具体的计算方法可参见应用指南 AN-641。						

## QoffsetN N 线无功功率失调

类	址: 3AH 型:读/写 认值: 0000								
	15		14	13	12	11	10	9	8
	QoffsetN1	.5 Qoft	SsetN14	QoffsetN13	QoffsetN12	QoffsetN11	QoffsetN10	QoffsetN9	QoffsetN8
	7		6	5	4	3	2	1	0
	QoffsetN'	7 Qof	fsetN6	QoffsetN5	QoffsetN4	QoffsetN3	QoffsetN2	QoffsetN1	QoffsetN0
	位名称描述								
		15 - 0       QoffsetN[15:0]       N 线无功功率失调。         补码,MSB 为符号位。具体的计算方法可参见应用指南 AN-641。						•	

#### CS2 校验码 2

地址: 3BH 类型:读/写 默认值: 0000H 15 14 13 12 11 10 9 8 CS2\_15 CS2\_14 CS2\_13 CS2\_12 CS2\_11 CS2\_10 CS2 9 CS2\_8 7 6 5 3 2 0 1 CS2\_7 CS2\_6 CS2\_5  $CS2_4$ CS2\_3 CS2\_2 CS2\_1 CS2\_0 名称 描述 位 CS2 寄存器需在 31H-3AH 寄存器配置完成后写入。假设 31H-3AH 寄存器的高字和低字如下表所示: 寄存器地址 高字 低字 H<sub>31</sub> 31H L<sub>31</sub> H<sub>32</sub> L<sub>32</sub> 32H H<sub>33</sub> 33H L<sub>33</sub> L<sub>34</sub> H<sub>34</sub> 34H H<sub>35</sub> L<sub>35</sub> 35H H<sub>36</sub> 36H L<sub>36</sub> 15 - 0 CS2[15:0] H<sub>37</sub> L<sub>37</sub> 37H H<sub>38</sub> 38H L<sub>38</sub> H<sub>39</sub> L<sub>39</sub> 39H H<sub>3A</sub> L<sub>3A</sub> 3AH CS2 寄存器值的算法如下: 3BH 寄存器低字: L<sub>3B</sub>=MOD(H<sub>31</sub>+H<sub>32</sub>+...+H<sub>3A</sub>+L<sub>31</sub>+L<sub>32</sub>+...+L<sub>3A</sub>, 2^8), MOD 为取模 3BH 寄存器高字: H<sub>3B</sub>=H<sub>31</sub> XOR H<sub>32</sub> XOR ... XOR H<sub>3A</sub> XOR L<sub>31</sub> XOR L<sub>32</sub> XOR ... XOR L<sub>3A</sub>, XOR 为异或 芯片定期计算 CS2 值。如果 CS2 寄存器值与芯片计算的 CS2 值不一致且 AdjStart 寄存器值为 8765H,则

AdjErr[1:0] 位 (SysStatus, 01H) 置位。

注: CS2 寄存器的读出值为芯片计算值,与芯片被写入的值不同。

## 5.4 电能寄存器

## <u>电能寄存器工作原理</u>

芯片内部电能的最小分辨率为 0.01 个脉冲,在 0.01 个脉冲发生期间,正反向电能抵消。当电能达到 0.01 个脉冲时,根据该 0.01 个脉冲的电能方向计入相应电能。有功 / 无功的绝对值和中,正反向电能不抵消。以有功为例,如:

T0 状态: 正向电能累计值为 12.34 个脉冲,反向电能累计值为 1.23 个脉冲.

T0 到 T1 状态: 出现 0.005 个正向脉冲, T1 到 T2 状态: 出现 0.004 个反向脉冲, T2 到 T3 状态: 出现 0.003 个反向脉冲。

	T0	T1	T2	Т3
正向有功脉冲	12. 34	12. 345	12. 341	12. 34
反向有功脉冲	1. 23	1. 23	1. 23	1. 232
有功绝对值脉冲	15. 57	15. 575	13. 579	13. 582

当正/反向电能值或绝对值电能累计超过 0.1 个脉冲,相应的寄存器中数据更新。当正/反向电能值或绝对值电能累计超过1 个脉冲,CFx 输出脉冲,并更新 REVP/REVQ 位(EnStatus,46H)。

绝对值和的电能量可能大于正向与反向之和,如果系统应用中需要保证绝对值电能和与正反向电能的'一致性',可分别读取正向 / 反向电能后计算得出。

#### APenergy 正向有功电能

类	址: 40H 型: 读后清 认值: 0000								
	15	14	13	12	11	10	9	8	
	APenergy1	5 APenergy	APenergy13	APenergy12	APenergy11	APenergy10	APenergy9	APenergy8	
	7	6	5	4	3	2	1	0	
	APenergy7 APenergy6		y6 APenergy5	APenergy4	APenergy3	APenergy2	APenergy1	APenergy0	
	位	名称	描述						
	15 - 0	APenergy[15:0]	/[15:0] 正向有功电能, 读后清零。 数据格式为 XXXX. X 个脉冲, 分辨率为 0.1 个脉冲, 最大为 6553.5 个脉冲。						

#### ANenergy 反向有功电能

地址: 41H 类型: 读后清 默认值: 0000H										
	15 14			13	12	11	10	9	8	
	ANenergy15		ANenergy14		ANenergy13	ANenergy12	ANenergy11	ANenergy10	ANenergy9	ANenergy8
	7		6		5	4	3	2	1	0
	ANenergy7		ANenergy6		ANenergy5	ANenergy4	ANenergy3	ANenergy2	ANenergy1	ANenergy0
	位		名称	描述						
	15 - 0	AN	energy[15:0]	反向有功电能, 读后清零。 数据格式为 XXXX. X 个脉冲, 分辨率为 0.1 个脉冲, 最大为 6553.5 个脉冲。						

#### ATenergy 有功电能绝对值和

	42H 读后清 : 0000										
	15		14		13	12	11	10	9	8	
ATe	ATenergy15 ATenergy14			14	ATenergy13	ATenergy12	ATenergy11	ATenergy10	ATenergy9	ATenergy8	
	7 6			5	4	3	2	1	0		
AT	ATenergy7 ATenergy6 ATenergy5 ATenergy4 ATenergy3						ATenergy3	ATenergy2	ATenergy1	ATenergy0	
位	泣	3	 名称	描述							
15	15 - 0 ATenergy[15:0] 有功电能绝对值和,读后清零。 数据格式为 XXXX. X 个脉冲,分辨率为 0. 1 个脉冲,最大为 6553. 5 个脉冲。										

#### RPenergy 正向 (感性) 无功电能

地址: 43H 类型: 读后清 默认值: 0000								
15	14	13	12	11	10	9	8	
RPenergy1	.5 RPenergy	RPenergy13	RPenergy12	RPenergy11	RPenergy10	RPenergy9	RPenergy8	
7	6	5	4	3	2	1	0	
RPenergy	7 RPenerg	y6 RPenergy5	RPenergy4	RPenergy3	RPenergy2	RPenergy1	RPenergy0	
位名称描述								
15 - 0	15 - 0 RPenergy[15:0] 正向 (感性) 无功电能, 读后清零。 数据格式为 XXXX. X 个脉冲, 分辨率为 0. 1 个脉冲, 最大为 6553. 5 个脉冲。							

#### RNenergy 反向 (容性) 无功电能

类	址: 44H 型: 读后清 认值: 0000								
	15	14	13	12	11	10	9	8	
	RNenergy15 RNenergy		RNenergy13	RNenergy12	RNenergy11	RNenergy10	RNenergy9	RNenergy8	
	7	6	5	4	3	2	1	0	
	RNenergy	7 RNenergy	y6 RNenergy5	RNenergy4	RNenergy3	RNenergy2	RNenergy1	RNenergy0	
	位	名称 描述							
	15 - 0   RNenergy[15:0]   反向 (容性) 无功电能, 读后清零。 数据格式为 XXXX. X 个脉冲, 分辨率为 0.1 个脉冲, 最大为 6553.5 个脉冲。								

#### RTenergy 无功电能绝对值和

类	址: 45H 型: 读后清 认值: 0000									
	15		14		13	12	11	10	9	8
	RTenergy15 RTenergy		14	RTenergy13	RTenergy12	RTenergy11	RTenergy10	RTenergy9	RTenergy8	
	7		6		5	4	3	2	1	0
	RTenergy7 RTenergy			76	RTenergy5	RTenergy4	RTenergy3	RTenergy2	RTenergy1	RTenergy0
位名称描述										
	T功电能绝对值和, 读后清零。									

#### EnStatus 计量状态

地址: 46H 类型: 读

类型: 读 上电复位值:	С800Н											
15	14	1	3	12	11	10	9	8				
Qnoload	Pnoloa	d Re	vQ	RevP	Lline	-	_	_				
7	6	,	5	4	3	2	1	0				
LNchange	RevQch	g Rev	Pchg	-	-	-	LNMode1	LNMode0				
位	名称 描述											
15	Qnoload	0: 非潜动	台示当前是否处于无功潜动状态。 : 非潜动 (无功) : 潜动 (无功)									
14	Pnoload	0: 非潜动	后示当前是否处于有功潜动状态。 : 非潜动 (有功) : 潜动 (有功)									
13	RevQ	0: 无功正向 1: 无功反向	指示上一 CF2 (无功输出)的方向。 0: 无功正向 1: 无功反向 注: 当 CF2 输出设置为电能绝对值和时,该位恒为 0。									
12	RevP	0: 有功正向 1: 有功反向		)的方向。 能绝对值和时,	该位恒为 0。							
11	Lline	指示防窃电标 0: N线 1: L线	莫式下当前计算	量采用的线路。								
10 - 2	-	保留位。										
1 - 0	1-0     LNMode[1:0] 位指示引脚 MMD0 引脚 LNMode1 位 LNMode0 位 L/N 计量模式       0											

#### 测量量寄存器 5. 5

# Irms L 线电流有效值

孝	也址: 48H <型: 读 状认值: 0000	Н						
	15	14	13	12	11	10	9	8
	Irms15	Irms14	4 Irms13	Irms12	Irms11	Irms10	Irms9	Irms8
	7	6	5	4	3	2	1	0
	Irms7	Irms6	Irms5	Irms4	Irms3	Irms2	Irms1	Irms0
位名称描述								
L 线电流有效值。 数据格式为 XX. XXX, 对应 0 ~ 65. 535A。 如果电流超过 65. 535A,建议在应用中由 MCU 自行处理,如在校表时将寄存器中再乘以 2 即可。							寄存器值校准到	实际值的 1/2,应用

# Urms 电压有效值

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
b址: 49H								
<sup>美型</sup> : 读 代认值: 0000	Н							
 15	14		13	12	11	10	9	8
Urms15	Urms14	Urr	ns13	Urms12	Urms11	Urms10	Urms9	Urms8
7	6		5	4	3	2	1	0
Urms7	Urms6	Ur	ms5	Urms4	Urms3	Urms2	Urms1	Urms0
位	名称				描述	述		
15 - 0	Urms[15:0]	电压有效值。 数据格式为	XXX. XX,	对应 0 ~ 655. 35	5V.			

# Pmean L线有功平均功率

类	址: 4AH 型: 读 认值: 0000	iH									
	15	14		13	12	11	10	9	8		
	Pmean15	Pmea	n14	Pmean13	Pmean12	Pmean11	Pmean10	Pmean9	Pmean8		
	7	6		5	4	3	2	1	0		
	Pmean7	Pmea	n6	Pmean5	Pmean4	Pmean3	Pmean2	Pmean1	Pmean0		
	位	名称		描述							
	15 - 0	Pmean[15:0	补码	L 线有功平均功率。 补码,MSB 为符号位。数据格式为 XX. XXX,对应 -32. 768 ~ +32. 767kW。 如果电流经过 MCU 倍数处理,芯片的功率与实际功率则存在与电流相同的倍数关系。							

# Qmean L 线无功平均功率

地址: 4BH 类型: 读 默认值: 0000	DН						
15	14	13	12	11	10	9	8
Qmean15	Qmean1	4 Qmean13	Qmean12	Qmean11	Qmean10	Qmean9	Qmean8
7	6	5	4	3	2	1	0
Qmean7	Qmean6	Qmean5	Qmean4	Qmean3	Qmean2	Qmean1	Qmean0
位	名称			描述	<b>₺</b>		
L 线无功平均功率。							

# Freq 电压频率

类型	: 4CH !: 读 .值: 0000	)H						
 	15	14	13	12	11	10	9	8
	Freq15	Freq14	Freq	13 Freq12	Freq11	Freq10	Freq9	Freq8
	7 6		5	4	3	2	1	0
	Freq7 Freq6			Freq4	Freq3	Freq2	Freq1	Freq0
位名称描述								
15-0       Freq[15:0]       电压频率。         数据格式为 XX. XX,频率测量范围为 45. 00 ~ 65. 00Hz。如 1388H 对应于 50. 00Hz。							应于 50.00Hz。	

#### PowerF L 线功率因数

类	址: 4DH 型: 读 认值: 0000	Н							
	15	14		13	12	11	10	9	8
	PowerF15 PowerF		.4	PowerF13	PowerF12	PowerF11	PowerF10	PowerF9	PowerF8
	7	6		5	4	3	2	1	0
	PowerF7	PowerF	6	PowerF5	PowerF4	PowerF3	PowerF2	PowerF1	PowerF0
位名称描述							<b>龙</b>		
L 线功率因数。 15-0 PowerF[15:0]							)3E8H 对应功率因数		

#### Pangle L 线电压电流相角

地址: 4EH 类型: 读 默认值: 000	ОН							
15		14	13	12	11	10	9	8
Pangle1	5 Pa	angle14	4 Pangle13	Pangle12	Pangle11	Pangle10	Pangle9	Pangle8
7	7 6		5	4	3	2	1	0
Pangle	7 P	angle6	Pangle5	Pangle4	Pangle3	Pangle2	Pangle1	Pangle0
位	名称	描述 描述						
15 - 0	Pangle[1		L 线电压电流相角。 有符号数,MSB 为符	号位。数据格式为	为 XXX. X。相角范	围: -180.0~+	180.0度。	

#### Smean L 线视在平均功率

地址: 4FH 类型: 读 默认值: 0000	)H							
15	14	13	12	11	10	9	8	
Smean15	Smean1	4 Smean13	Smean12	Smean11	Smean10	Smean9	Smean8	
7	6	5	4	3	2	1	0	
Smean7	Smean6	Smean5	Smean4	Smean3	Smean2	Smean1	Smean0	
位     名称       描述								
15 - 0	Smean[15:0]	L 线视在平均功率。 补码,MSB 恒为 0。数据格式为 XX. XXX,对应的功率为: 0 ~ 32. 767kVA。 如果电流经过 MCU 倍数处理,芯片的功率与实际功率则存在与电流相同的倍数关系。						

### Irms2 N 线电流有效值

地址: 68H 类型:读 默认值: 0000	)H									
15 14		13	12	11	10	9	8			
Irms2_15	5 Irms2_1	.4 Irms2_13	Irms2_12	Irms2_11	Irms2_10	Irms2_9	Irms2_8			
7	6	5	4	3	2	1	0			
Irms2_7	Irms2_	6 Irms2_5	Irms2_4	Irms2_3	Irms2_2	Irms2_1	Irms2_0			
位	名称				<b></b>					
15 - 0	Irms2[15:0]		电流有效值。 居格式为 XX. XXX,对应 0 ~ 65. 535A。 是电流超过 65. 535A,建议在应用中由 MCU 自行处理,如在校表时将寄存器值校准到实际值的 1/2,应)							

#### Pmean2 N线有功平均功率

类	址: 6AH 型: 读 认值: 0000	)H								
	15	14	13	12	11	10	9	8		
	Pmean2_1	5 Pmean2_	14   Pmean2_13	Pmean2_12	Pmean2_11	Pmean2_10	Pmean2_9	Pmean2_8		
	7 6		5	4	3	2	1	0		
	Pmean2_7	Pmean2_	6 Pmean2_5	Pmean2_4	Pmean2_3	Pmean2_2	Pmean2_1	Pmean2_0		
	位	名称								
	15 - 0	N线有功平均功率。								

#### Qmean2 N 线无功平均功率

类	址: 6BH 型: 读 认值: 0000	θΉ									
	15	14		13	12	11	10	9	8		
	Qmean2_15 Qmean2_		_14	Qmean2_13	Qmean2_12	Qmean2_11	Qmean2_10	Qmean2_9	Qmean2_8		
	7 6			5	4	3	2	1	0		
	Qmean2_7	Qmean2	_6	Qmean2_5	Qmean2_4	Qmean2_3	Qmean2_2	Qmean2_1	Qmean2_0		
	位	名称		描述							
N 线无功平均功率。 补码,MSB 为符号位。数据格式为 XX. XXX,对应 -32. 768 ~ +32. 767kvar。 如果电流经过 MCU 倍数处理,芯片的功率与实际功率则存在与电流相同的倍数关系。											

#### PowerF2 N 线功率因数

地址: 6DH 类型: 读 默认值: 0000	ЭH								
15	14	13	12	11	10	9	8		
PowerF2_1	PowerF2_	PowerF2_13	PowerF2_12	PowerF2_11	PowerF2_10	PowerF2_9	PowerF2_8		
7	6	5	4	3	2	1	0		
PowerF2_	7 PowerF2	_6 PowerF2_5	PowerF2_4	PowerF2_3	PowerF2_2	PowerF2_1	PowerF2_0		
位	名称		描述						
15 - 0	N 线功率因数。 有符号数,MSB 为符号位。数据格式为 X. XXX。功率因数范围: -1.000 ~ +1.000。如 03E8H 对应功率因为 1.000。83E8H 对应功率因数为 -1.000。								

#### Pangle2 N线电压电流相角

地址: 6EH 类型: 读 默认值: 0000	ЭH								
15	14		13	12	11	10	9	8	
Pangle2_1	Pangle2_15 Pangle2_14		gle2_13	Pangle2_12	Pangle2_11	Pangle2_10	Pangle2_9	Pangle2_8	
7	6		5	4	3	2	1	0	
Pangle2_	7 Pangle2	2_6 Par	ngle2_5	Pangle2_4	Pangle2_3	Pangle2_2	Pangle2_1	Pangle2_0	
位	名称					<u></u> 赴			

### Smean2 N 线视在平均功率

类	1址: 6FH 5型: 读 3认值: 0000	ŀΗ										
	15		14		13	12	11	10	9	8		
	Smean2_15 Smean2		mean2_1	14	Smean2_13	Smean2_12	Smean2_11	Smean2_10	Smean2_9	Smean2_8		
	7 6		6		5	4	3	2	1	0		
	Smean2_7	, ,	Smean2_	6	Smean2_5	Smean2_4	Smean2_3	Smean2_2	Smean2_1	Smean2_0		
	位	名	称		描述							
	N 线视在平均功率。											

# 6 电气参数

# 6.1 技术指标

参数和说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件及注释
		准确度	ŧ		
电源直流抑制能力 PSRR			± 0.1	%	VDD=3. 3V ± 0. 3V, 100Hz, I=5A, V=220V, L 线锰铜电阻 150μΩ, N 线 CT 变比 1000:1, 采样电阻 4. 8Ω
电源交流抑制能力 PSRR			± 0.1	%	VDD=3. 3V 叠加 400mVrms, 100Hz 正弦信号, I=5A, V=220V, L 线锰铜电阻 150μΩ, N 线 CT 变比 1000:1, 采样电阻 4. 8Ω
有功电能误差 (动态范围 5000:1)			± 0.1	%	L 线电流通道增益为 24 倍, N 线电流通道增益为 1 倍
	Ī	通道性	能	****	T
采样频率		8		KHz	
L线电流通道等效输入噪声			19. 1	nV/√Hz	单边带噪声 (测于 50Hz, PGA 增益 =24 倍)
N线电流通道等效输入噪声			458. 4	nV/√Hz	单边带噪声(测于 50Hz, PGA 增益 =1 倍)
电压通道等效输入噪声			458. 4	nV/√Hz	单边带噪声(测于 50Hz, PGA 增益 =1 倍)
每通道的总谐波失真 THD	80			dB	25 ℃, PGA 增益 =1 倍, 500mVrms 输入信号
无功电能计量带宽		4		KHz	
有功电能计量带宽		4		KHz KHz	
电流电压有效值测量带宽		4	105		
测量量测量误差		 模拟输	$\pm 0.5$	%	
L 线电流通道的差分输入范围	5μ	(天) 外側	25m	Vrms	PGA 增益 =24 倍
N线电流通道的差分输入范围	120µ		600m	Vrms	PGA 增益 =1 倍
电压通道的差分输入范围	120µ		600m	Vrms	PGA 增益 =1 倍
L线电流通道的输入阻抗		1	000111	KΩ	1011-1111111111111111111111111111111111
N线电流通道的输入阻抗		50		KΩ	
电压通道的输入阻抗		50		KΩ	
L线电流通道的直流失调			0.02	mV	PGA 增益 =24 倍
N线电流通道的直流失调			0.02	mV	PGA 增益 =1 倍
电压通道的直流失调			0.02	mV	PGA 增益 =1 倍
		基准			
片上基准 (90E21/22)	1. 218	1. 258	1. 298	V	L线电流通道和电压通道开启
片上基准(90E23/24)	1. 127	1. 178	1. 230	V	L线/N线电流通道、电压通道同时开启
基准电压温度系数		± 15	± 40	ppm/ ℃	
		时钟		_	
晶体或外接时钟		8. 192	<u> </u>	MHz	晶体或外接时钟的准确度优于± 100ppm
CDI 按口U柱步	000	SPI 接		L	I
SPI 接口比特率	200	 	160k 唐	bps	
CFx 脉冲宽度		80		ms	当 T ≥ 160ms 时,为 80ms; 当 T<160ms 时, 为 0.5T。参见章节 6.6。
		静电放	电		
机器放电模式(MM)	400			V	JESD22-A115
充电器件放电模式 (CDM)	1000			V	JESD22-C101
人体放电模式 (HBM)	4000			V	JESD22-A114
Latch Up			± 100	mA	JESD78A
Latch Up			4.95	V	JESD78A

		运行条	件		
AVDD, 模拟电源	2.8	3.3	3.6	V	3. 0V 到 3. 6V 范围内保证准确度
DVDD,数字电源	2.8	3.3	3.6	V	3. 0V 到 3. 6V 范围内保证准确度
I <sub>AVDD</sub> ,模拟电流 (90E21/22)		3.00		mA	L线电流通道和电压通道开启
I <sub>AVDD</sub> ,模拟电流 (90E23/24)		3. 75		mA	L线/N线电流通道、电压通道同时开启
I <sub>DVDD</sub> ,数字电流		2.75		mA	VDD=3.3V
		直流特	性		
数字输入高电平(除 OSCI外所有数字输入引脚)	2.0		VDD+2.6	٧	VDD=3.3V $\pm$ 10%,
数字输入高电平 (OSCI)	2.0		VDD+0.3	٧	VDD=3.3V $\pm$ 10%
数字输入低电平			0.8	٧	VDD=3.3V $\pm$ 10%
数字输入漏电流			± 1	μΑ	VDD=3.6V, VI=VDD or GND
数字输出低电平 (CF1, CF2)			0.4	V	VDD=3.3V, I <sub>OL</sub> =10mA
数字输出低电平 (IRQ, WarnOut, ZX, SDO)			0.4	V	VDD=3.3V, I <sub>OL</sub> =5mA
数字输出高电平 (CF1, CF2)	2.4			V	VDD=3.3V, I <sub>OH</sub> =-10mA
数字输出高电平 (IRQ, WarnOut, ZX, SDO)	2.4			V	VDD=3.3V, I <sub>OH</sub> =-5mA
数字输出低电平 (OSCO)			0.4	V	VDD=3.3V, I <sub>OL</sub> =1mA
数字输出高电平(OSCO)	2.4			V	VDD=3.3V, I <sub>OH</sub> =-1mA

90E21/22/23/24 数据手册 高精度宽量程单相电能计量芯片

### 6.2 SPI 接口时序

SPI 接口的时序特征详见图 -10, 图 -11, 表 -12。

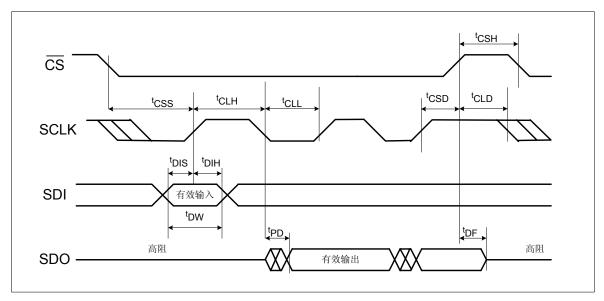


图-10 4线 SPI 时序图

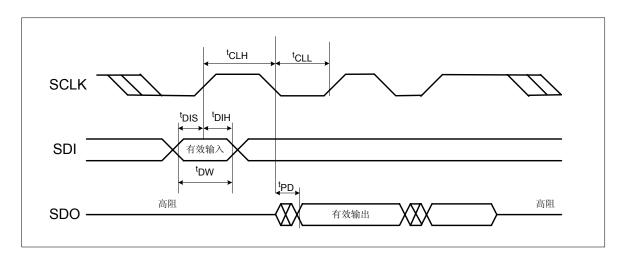


图-11 3线 SPI 时序图

表-12 SPI 时序特征

符号	描述	最小值	最大值	单位
$t_{CSH}^{-1}$	最小 CS 高电平时间	30T <sup>2</sup> +10		ns
$t_{CSS}^{-1}$	CS 建立时间	3T+10		ns
$t_{CSD}^{-1}$	CS 保持时间	30T+10		ns
$t_{CLD}^{-1}$	时钟解除时间	1T		ns
$t_{CLH}$	时钟高电平时间	30T+10		ns
$t_{CLL}$	时钟低电平时间	16T+10		ns
$t_{ m DIS}$	数据建立时间	3T+10		ns
t <sub>DIH</sub>	数据保持时间	22T+10		ns
t <sub>DW</sub>	最小数据宽度	30T+10		ns

电气参数 48 2010 年 9 月 3 日

### 表-12 SPI 时序特征 (续)

$\mathrm{t}_{\mathrm{PD}}$	输出延时	14T	15T+20	ns		
$\mathrm{t_{DF}}^{1}$	输出解除时间		16T+20	ns		
<b>注 1</b> : 3 线 SPI 不适用;	<b>注 1</b> : 3 线 SPI 不适用;					
注 2: T 代表 SCLK 时钟周期。T= 1/8. 192MHz = 122ns。(4 线 SPI 典型值)						

# 6.3 上电复位时序

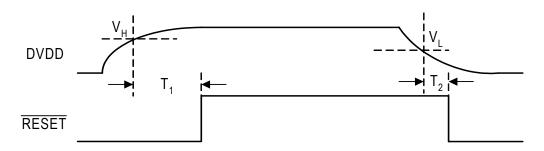


图-12 上电复位时序图

### 表-13 上电复位参数

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{H}$	上电触发电压	2. 47	2.6	2.73	V
$V_{L}$	断电触发电压	2. 185	2. 3	2. 415	V
$V_H - V_L$	滞回电压差	0. 285	0.3	0.315	V
$T_1$	上电后延时	5			ms
$T_2$	断电后延时	10			μs

90E21/22/23/24 数据手册 高精度宽量程单相电能计量芯片

### 6.4 过零信号时序

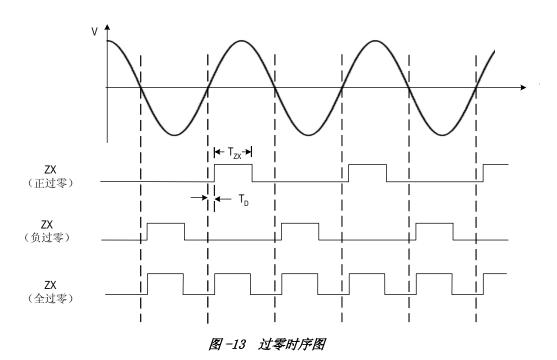


表-14 过零信号参数

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
$T_ZX$	高电平宽度		5		ms
T <sub>D</sub>	延时			0.5	ms

90E21/22/23/24 数据手册 高精度宽量程单相电能计量芯片

### 6.5 失压时序

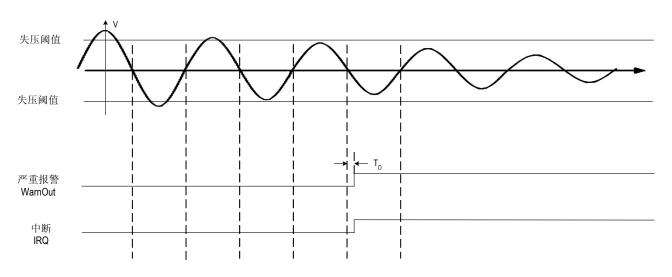


图-14 失压时序图

#### 表-15 失压参数

符号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
T <sub>D</sub>	延时			0.5	ms

# 6.6 脉冲输出

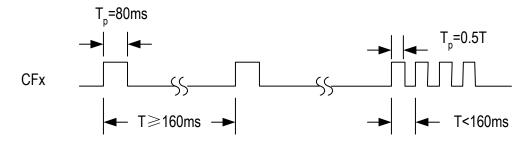


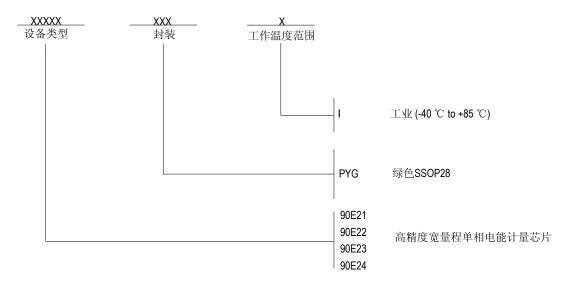
图-15 脉冲输出宽度

# 6.7 极限参数和热特性

参数	最大极限
AVDD 到 AGND 的相对电压	$-0.3$ V $\sim 3.7$ V
DVDD 到 DGND 的相对电压	$-0.3$ V $\sim 3.7$ V
模拟输入电压 (I1P, I1N, I2P, I2N, VP, VN)	$-0.3V\sim VDD$
数字输入电压	-0.3V $\sim$ VDD+2.6V
工作温度范围	-40 ∼ 85 °C
最高结温	150 ℃

封装类型	热阻 θ <sub>JA</sub>	单位	条件		
绿色 SS0P28 <sup>1</sup>	63. 2	°C /W	无气流		
注 1: 参见 http://www.idt.com/?app=packaging&partID=90E21PYGI&packageID=PYG28&mktseg=IDT					

# 订货信息



# 修改历史记录

2010年9月2日 第6、14、24、25、30、31、35、46、47、50、51、52、53页



公司总部 6024 Silver Creek Valley Road San Jose, CA 95138 www.idt.com *销售* 86-21-64958900 技术支持: 86-21-64958900 email:powermeterhelp@idt.com